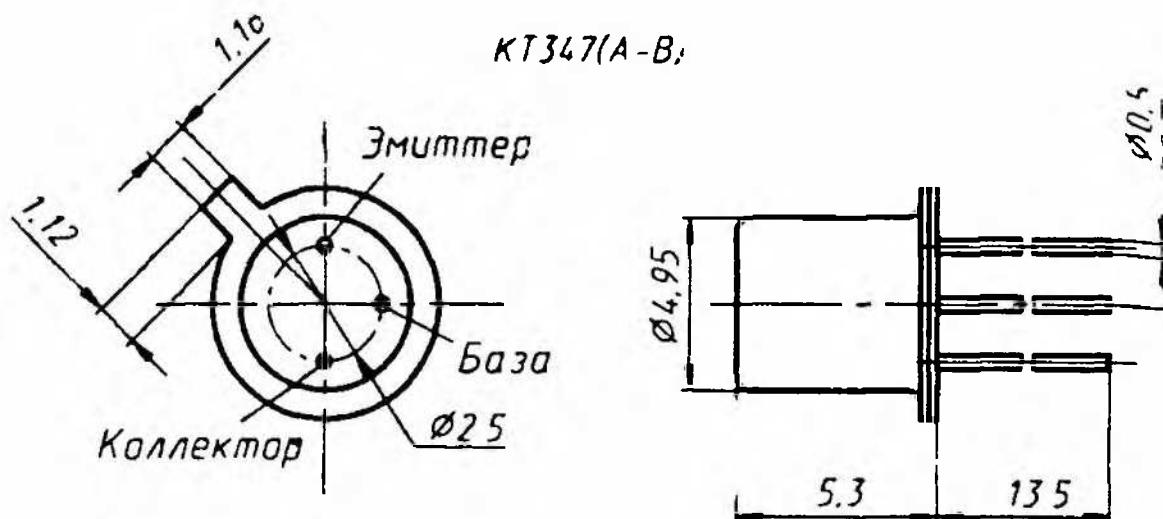


KT347A, KT347B, KT347B

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры $p-n-p$ универсальные. Предназначены для применения в усилителях высокой частоты и импульсных устройствах. Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 0,5 г.



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока
в схеме ОЭ при $U_{KB} = 0,3$ В, $I_3 = 10$ мА:

$T = +25$ °C, не менее:

KT347A, KT347B 30...400

KT347B 50...400

$T = -40$ °C:

KT347A, KT347B 9...600

KT347B 15...600

$T = +85$ °C:

KT347A, KT347B 15...1000

KT347B 25...1000

Граничная частота коэффициента передачи
тока при $U_{KB} = 5$ В, $I_3 = 10$ мА, не менее 500 МГц

Время рассасывания при $I_K = 10$ мА,

$I_{B1} = I_{B2} = 1$ мА, не более:

KT347A, KT347B 25 нс

KT347B 40 нс

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер
при $I_K = 10$ мА, $I_B = 1$ мА, не более 0,3 В

Обратный ток коллектора при $U_{KB} = U_{KB, \text{МАКС}}$,
не более:

$T = +25^\circ\text{C}$	1 мкА
$T = +85^\circ\text{C}$	20 мкА

Обратный ток коллектор—эмиттер

при $U_{KE} = U_{KE, \text{МАКС}}$, $R_{B3} = 10 \text{ кОм}$, не более

5 мкА

Обратный ток эмиттера при $U_{EB} = 4 \text{ В}$,

не более

10 мкА

Емкость коллекторного перехода

при $U_{KB} = 5 \text{ В}$, не более

6 пФ

Емкость эмиттерного перехода при $U_{EB} = 0$,

не более

8 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянные напряжения коллектор—база,

коллектор—эмиттер при $R_{B3} = 10 \text{ кОм}$:

KT347A..... 15 В

KT347Б..... 9 В

KT347В..... 6 В

Постоянное напряжение база—эмиттер

4 В

Постоянный ток коллектора

50 мА

Импульсный ток коллектора

110 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллек-

тора¹:

при $T \leq +55^\circ\text{C}$

150 мВт

при $T = +85^\circ\text{C}$

130 мВт

Температура $p-n$ перехода

+150 °C

Температура окружающей среды

-40...+85 °C

В диапазоне температур +55...+85 °C допустимое значение рассеиваемой
мощности снижается линейно.